

Typ tranzystora: tranzystor krzemowy

Firma: TESLA

Wykonanie: tranzystor polowy MOS kanał typu P, o dużej rezystancji wejściowej, w obudowie metalowej, podłoże połączone galwanicznie z obudową

Zastosowanie: wzmacniacze, układy impulsowe i przełączające

Typy podobne: MEM551 (Int)

Rys. 1-799. KF551

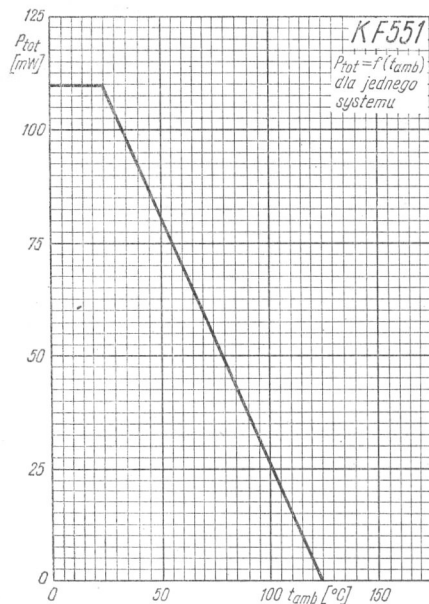
Wartości charakterystyczne¹⁾

I_{GSS}	< 4	pA	przy $U_{GS} = -40$ V, $U_{DS} = 0$
$-U_T$	3 ÷ 6	V	przy $U_{GS} = U_{DS}$, $I_{DS} = 10$ μ A
I_{DS}	5	> 1,5	mA przy $U_{GS} = U_{DS} = -10$ V
I_{DSS}	< 10	nA	przy $U_{GS} = 0$, $U_{DS} = -20$ V
I_{SDS}	< 10	nA	przy $U_{GS} = 0$, $U_{SD} = -20$ V
$-U_{(BR)DSS}$	50	> 30	V przy $U_{DS} = 0$, $I_{DS} = 10$ μ A
$-U_{(BR)SDS}$	50	> 30	V przy $U_{DS} = 0$, $I_{SD} = 10$ μ A
y_{21e}	1,5	> 0,5	mS przy $U_{DS} = -10$ V, $I_{DS} = 5$ mA, $f = 1$ kHz
C_{GS}	1,1		pF przy $U_{GS} = U_{DS} = -10$ V
C_{GD}	1,1		pF przy $U_{GS} = U_{DS} = -10$ V
C_{DS}	0,15		pF przy $U_{GS} = U_{DS} = -10$ V
$R_{DS(ON)}$	250		Ω przy $U_{GS} = -15$ V, $U_{DS} = -0,1$ V
y_{21eI}/y_{21eII}	0,8 ÷ 1		przy $U_{DS} = -10$ V, $I_{DS} = 5$ mA, $f = 1$ kHz
ΔU_T	70	200	mV przy $U_{DS} = -10$ V, $I_{DS} = 10$ μ A

Wartości graniczne¹⁾

U_{DSM} max	-30	V
U_{SDM} max	-30	V
U_{GSM} max	-40	V
U_{GDM} max	-40	V
I_{DSM} max	25	mA
P_{tot} max	110	mW
t_{stg}	-55 ÷ +125	$^{\circ}$ C

¹⁾ $t_{amb} = \sim 25^{\circ}$ C



Rys. 1-800. Zależność maksymalnej mocy strat od temperatury otoczenia